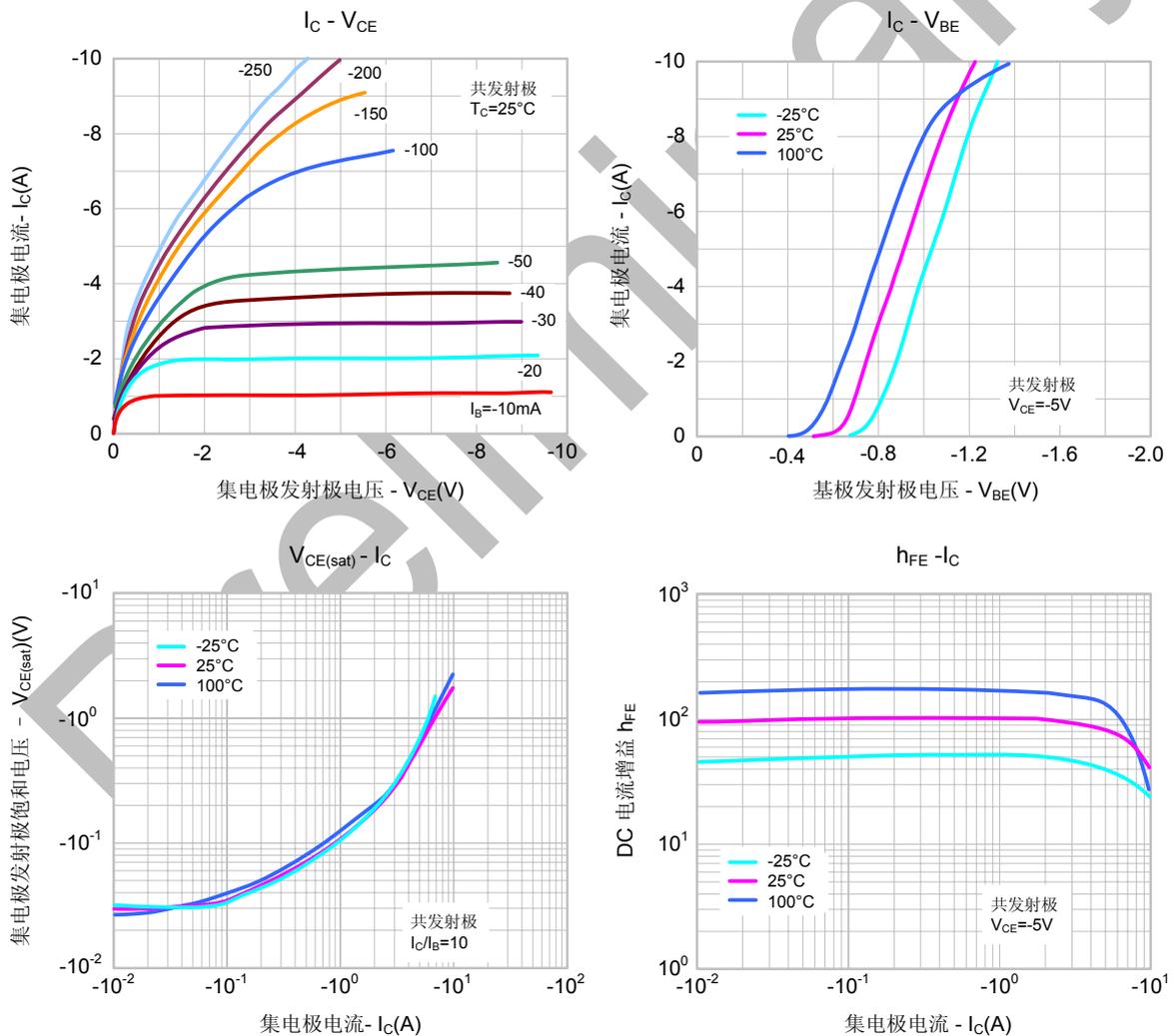


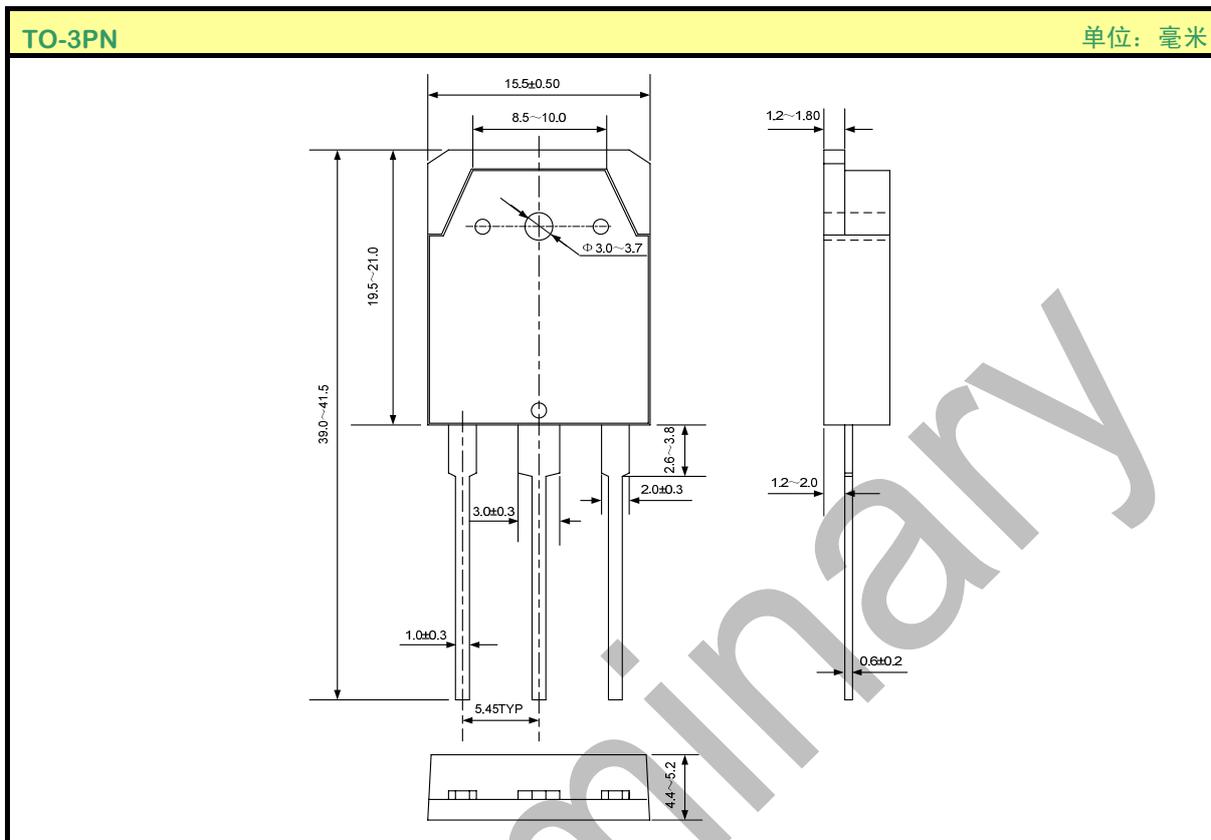


**电参数(除非特殊说明,  $T_C=25^\circ\text{C}$ )**

参数	符号	测试条件	最小值	典型	最大值	单位
直流电流增益	HFE	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$	55	-	160-	-
		$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-5\text{A}$	35	80	-	-
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-7\text{A}, I_B=-0.7\text{A}$	-	-0.5	-2	V
基极、发射极电压	$V_{BE}$	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-5\text{A}$	-	-1	-1.5	V
集电极、基极漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CE}=-140\text{V}, I_B=0$	-	-	-5	$\mu\text{A}$
发射极、基极漏电流	$I_{EBO}$	$V_{CB}=-5\text{V}, I_C=0$	-	-	-5	$\mu\text{A}$
集电极输出电容	$C_{OB}$	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	350	-	pF

**典型特性曲线**


封装外形图



声明:

- 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！